物理学报 Acta Physica Sinica



112型铁基化合物 EuFeAs₂ 的单晶生长与表征

于佳 刘通 赵康 潘伯津 穆青隔 阮彬彬 任治安

Single crystal growth and characterization of the 112-type iron-pnictide EuFeAs₂

Yu Jia Liu Tong Zhao Kang Pan Bo-Jin Mu Qing-Ge Ruan Bin-Bin Ren Zhi-An

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 67, 207403 (2018) DOI: 10.7498/aps.67.20181393 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.67.20181393 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2018/V67/I20

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

铁基超导1111体系CaFeAsF的单晶生长和物性研究

Single crystal growth and physical property study of 1111-type Fe-based superconducting system CaFeAsF 物理学报.2018, 67(17): 177401 http://dx.doi.org/10.7498/aps.67.20181371

压力下碱金属铁硒基超导体中的现象与物理

Phenomena and findings in pressurized alkaline iron selenide superconductors 物理学报.2015, 64(21): 217406 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.217406

铁基氟化物超导体 $SrFe_{1-x}Co_x AsF(x=0, 0.125)$ 声子特性的第一性原理计算研究

First-principles study on phonon properties of iron-based fluoride superconductors $SrFe_{1-x}Co_xAsF$ (x=0, 0.125)

物理学报.2014, 63(9): 097401 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.097401

β 型烧绿石氧化物超导体 AOs_2O_6 (A=K, Rb) 的声子软化与超导电性

Phonon softening and superconductivity of β -pyrochlore oxide superconductors AOs₂O₆ (A=K, Rb) 物理学报.2012, 61(13): 137402 http://dx.doi.org/10.7498/aps.61.137402

专题: 铁基高温超导体发现十周年

112型铁基化合物 $EuFeAs_2$ 的单晶生长与表征^{*}

于佳¹⁾²⁾ 刘通¹⁾²⁾ 赵康¹⁾²⁾ 潘伯津¹⁾²⁾ 穆青隔¹⁾²⁾ 阮彬彬¹⁾²⁾ 任治安^{1)2)3)†}

1)(中国科学院物理研究所,北京凝聚态物理国家研究中心,北京 100190)

2) (中国科学院大学物理科学学院, 北京 100049)

3) (量子物质科学协同创新中心, 北京 100190)

(2018年7月20日收到;2018年8月10日收到修改稿)

铁基超导体中含有一类特殊的 112型结构化合物,其层状结构中含有一层锯齿形的 As 链构型.本文报 道了用 CsCl 助熔剂法生长新型铁基 112型 EuFeAs₂ 母体单晶的具体方法,以及对该单晶的结构和物性的详 细表征.通过能量色散 X 射线能谱扫描对单晶样品进行的化学成分分析,以及单晶 X 射线衍射的结构解析, 确定该单晶样品属于 EuFeAs₂ 相,结构精修得到 EuFeAs₂ 具有空间群为 *Imm*2 (No. 44)的正交晶体结构,晶 格常数分别是 a = 21.285(9) Å, b = 3.9082(10) Å, c = 3.9752(9) Å.通过低温电阻测量,发现在 110 K 附近 和 46 K 附近存在两个异常电阻跳变.进一步分析表明,110 K 附近存在两个邻近的相变,这两个相变与铁基 母体材料中常见的结构相变和 Fe²⁺ 的反铁磁相变相符合.结合磁化率测量分析,可知 46 K 附近的相变属于 Eu²⁺ 的反铁磁相变.

关键词: EuFeAs₂, 单晶生长, 结构相变, 反铁磁相变 PACS: 74.70.-b, 74.70.Xa, 74.25.-q

1引言

对于铜氧化物和铁基高温超导,由于其超导 现象往往发生在体系中的反铁磁序被压制之后, 同时反铁磁自旋涨落目前被部分研究者认为是高 温超导电子配对的关键因素,所以对高温超导体 中反铁磁序和超导序的竞争与共存关系的研究对 理解高温超导机理非常重要.对于铁基超导体来 说,其母体材料在低温下大都是反铁磁的坏金属, 一般通过化学掺杂、载流子调制或压力调制等手 段可以抑制母体材料中的反铁磁序,进而引发超 导电性. 铁基超导体发现十年以来^[1],随着多种 不同类型超导体系的发现,展现出丰富多彩的电 子态相图^[2].在不同体系铁基超导体的化学掺杂 相图中,超导序和反铁磁序的关系非常不同.如

DOI: 10.7498/aps.67.20181393

在 122 体系的 $AeFe_2As_2$ (Ae = 碱土金属或Eu)中, 通过掺杂,母体的反铁磁序被压制,超导序产生, 但反铁磁序和超导序存在一定的共存区域^[3];而 在 LaFeAs(O, F)^[4], CeFeAs(O, F)^[5]中,超导相 仅在反铁磁相被完全压制后才出现,两者不共存. 随后在 2013 年发现的 112 体系的 (Ca, *RE*)FeAs₂ 中^[6],则表现出了更有趣的反铁磁序与超导序的关 系:在La掺杂的 Ca_{1-x}La_xFeAs₂中,仅在La掺杂 量 $x \ge 0.15$ 时才有稳定的相存在,其中x = 0.15时 有最高 $T_c = 35$ K,然后随着掺杂量增加,超导转 变温度逐渐降低,并在x = 0.25时超导消失.然而 Ca_{1-x}La_xFeAs₂的反铁磁序并没有因掺杂量的增 加而被压制,反而逐渐增强,具体表现为反铁磁温 度从x = 0.15的 62 K提升到了x = 0.24的 70 K^[7]. 这使得 112 体系成为一类非常特殊的铁基超导体,

* 国家重点基础研究发展计划(批准号: 2016YFA0300301)、国家自然科学基金(批准号: 11474339, 11774402)和中国科学院青年创 新促进会优秀会员基金资助的课题.

†通信作者. E-mail: renzhian@iphy.ac.cn

© 2018 中国物理学会 Chinese Physical Society

对其深入研究可能对理解高温超导的配对机理与 反铁磁序的关系提供重要思路. 另一方面, 112体 系的 (Ca, RE)FeAs₂ 由 (Ca, RE)₂As₂ 层与 Fe₂As₂ 层堆叠而成, (Ca, RE)₂As₂层中存在一个金属性 的砷平面,角分辨光电子能谱测量和理论计算分别 指出 (Ca, RE)FeAs2 中的 (Ca, RE)2As2 和 Fe2As2 层之间有很强的耦合^[8].独立存在的砷平面在铁 基10-4-8体系Ca₁₀ (M_4As_8) (Fe_{2-x} M_xAs_2)₅ (M =Pt, Ir, Pd)和非铁基112体系材料如SmAuAs₂和 LaAgAs2 中都有发现^[9,10], 其中在10-4-8 体系中砷 平面的As是+2价,而在(Ca, RE)FeAs₂以及类似 的SmAuAs₂和LaAgAs₂中, 砷平面由-1价的As-构成. 铁基112材料独特的晶体结构和电子态相图 引人注目,但是在(Ca, RE)FeAs2中只能通过+3 价的稀土离子部分替换Ca²⁺得到稳定的相, 母体 材料CaFeAs2和低掺杂的样品至今没有成功合成, 这使得112体系的电子态相图很不完整,对于理解 该体系铁基超导体中反铁磁序和超导序的关系很 难进一步深入研究.

最近,Yu等^[11]报道了新型112结构化合物 EuFeAs₂的发现及掺杂诱发的超导电性,为详细 研究铁基112体系提供了新的平台.该Eu112体系 可以通过固相反应法和助熔剂方法分别制备多晶 和单晶样品,并且未掺杂母体样品可以稳定存在. 本文介绍我们在EuFeAs₂单晶生长探索中的工作, 以及用助熔剂法成功生长EuFeAs₂单晶的方法,并 对EuFeAs₂母体单晶的基本性质进行了表征.

2 单晶生长与表征

在尝试了多种助熔剂生长方法和单晶生长 条件之后,发现CsCl是生长EuFeAs2单晶的良 好助熔剂.实验中将单质元素与助熔剂原料按 Eu:Fe:As:CsCl=1:1:4:18的摩尔比例混 合,抽真空后封入石英管中(真空度10⁻⁴ Pa).将样 品竖直放置于箱式马弗炉内,缓慢加热至800°C, 在恒温条件下保持300h后降温取出.将助熔剂和 样品混合物用蒸馏水超声清洗后可以得到大小不 一的片状EuFeAs2单晶.实验中制备样品的操作 需要在高纯氩气保护的手套箱内完成,以防止样品 的氧化,另外CsCl助熔剂在使用前也需要加热脱 水处理.

对生长的 EuFeAs₂ 单晶, 样品表面形貌和化学 成分通过 Phenom(飞纳) 公司的 Phenom Pro X 台

式扫描电子显微镜 (SEM) 及能量色散 X 射线光谱 仪 (EDX) 进行表征. 样品的晶体结构利用 Bruker 的 D8 VENTURE 单晶衍射仪 Mo 靶的 K_α射线进 行表征和解析. 样品的电、热输运测量与磁化率测 量分别在 Quantum Design 公司的综合物性测量系统 (PPMS) 与磁性测量系统 (MPMS) 上进行.

3 结果与讨论

考虑到之前已经发现的112型铁基超导体只 有稀土掺杂的 (Ca, RE)FeAs₂一种 (RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd)^[12], 并且该Cal12化合物只 有利用+3价稀土离子对部分二价Ca2+离子掺杂 替代后才能稳定成相,非掺杂的母体材料至今无 法合成. 而对于稀土元素Eu而言, 在不同化合物 中可表现出+2价或者+3价的可变价态,甚至在 122型铁基EuFe₂As₂中,通过加压和掺杂的方式都 可以引起Eu离子的价态在+2价和+3价之间变 化^[13,14]. 考虑 Eu 离子的变价特性, 同时 Eu²⁺ 具有 与Ca²⁺相近的离子半径,选取Eu作为切入点,尝 试合成112型EuFeAs2新型铁基超导母体材料. 经 过在各种实验条件下的多次探索,成功得到了稳 定的铁基112母体EuFeAs2新相,并且对该母体化 合物的多晶成相条件和单晶生长方法都进行了优 化. 在EuFeAs2样品合成时有两点需要特别注意, 一是EuFeAs2成相的温度窗口很窄,仅有约50°C, 反应温度稍高就会得到122型的EuFe₂As₂相,这 使EuFeAs2单晶的生长不能使用铁基超导体中常 用的FeAs 作为助熔剂,反应温度稍低则产物大都 是二元杂相,没有112相生成.二是在单晶生长时 通过加大As的化学配比,使得三元相区向富As相 移动,可以有效减少122相及FeAs杂相的生成,从 而提高112相产量,并使单晶分离更加容易,提高 晶体质量.

通过CsCl助熔剂法成功生长了尺寸约 1.0 mm×1.0 mm×0.2 mm的片状单晶,其表面 呈金属光泽,如图1(a)所示.图1(b)展示了SEM 下观测到的EuFeAs2单晶的表面形貌.单晶表面 光滑,有阶梯状的纹路,说明单晶呈现典型的层状 特性.选取干净的平面做能量色散X射线谱区域 扫描,得到EuFeAs2单晶样品中三种元素比例为 Eu:Fe:As = 1:1.04:2.47 (实验中经常观测 到As比例略高,可能源自晶体表面未除净的As). 选取尺寸约100 μ m的单晶做了常温下的X射线 单晶衍射分析,并对359个独立的衍射点进行了 单晶结构解析.表1给出了结构精修的相关参数 以及EuFeAs2晶体结构参数,较小的残差因子以 及接近1的拟合优度说明精修结果具有很高的可 靠性.精修结果确认该单晶化学配比为EuFeAs2, 其晶体结构属于正交的Imm2 (No. 44)空间群, 晶格常数a = 21.285(9) Å, b = 3.9082(10) Å, c = 3.9752(9) Å.根据单晶结构解析得到的原子 位置所画出的EuFeAs2晶体结构示意图如图2所 示.相对于Ca112体系^[6],晶格沿着垂直于Fe2As2 层的方向拓展了一倍,与As链相邻的两个Eu²⁺离 子层在a方向上投影重合.与此同时,As平面上 出现了两个不同等效位置的As:沿b方向看分别 是处于上下两列Eu²⁺离子中间的As2和处于上下



图 1 EuFeAs₂单晶样品的光学照片 (a) 与 SEM 表面形貌图 (b) Fig. 1. Optic image (a) and SEM image (b) of EuFeAs₂ single crystals.



图 2 EuFeAs₂ 的晶格结构示意图 (a) 以及 As 平面结构 示意图 (b)

Fig. 2. Crystal structure of $EuFeAs_2$ (a) and top view of arsenic layer in $EuFeAs_2$ (b).

表 1 EuFeAs₂ 单晶 X 射线衍射精修结果与晶体学参数 Table 1. Data collection and refinement statistics for the X-ray structure determination of EuFeAs₂ single crystal.

Data	tem Or	n Orthorhombic				
Space group			Im	<i>Imm2</i> (No. 44)		
$a/{ m \AA}$			21.285(9)			
$b/{ m \AA}$			3.9082(10)			
$c/{ m \AA}$			3.9752(9)			
$lpha,eta,\gamma/(^\circ)$:	90, 90, 90		
R1				0.0325		
Completeness/%				99.5		
Redundancy				3.99		
wR2				0.0769		
Inc	dependent re	3	359			
GOOF			1.09			
Element	x	y	z	Occ.	<u>U</u>	
Eu	0.38602(3)	1.0000	0.75155(17)	1.000	0.0072(4)	
As1	0.31613(7)	0.5000	0.2521(6)	1.000	0.0071(4)	
As2	0.5000	0.5000	0.6730(7)	1.000	0.0111(7)	
As3	0.5000	1.0000	0.2583(11)	1.000	0.0090(5)	
Fe	0.24970(10)	0.0000	0.2489(9)	1.000	0.0071(5)	

左右四列 Eu^{2+} 离子中间的As3. As 平面上最近 邻 As-As间距为2.557(3)Å,次近邻As-As间距为 3.038(4)Å. 和Ca112体系相似, EuFeAs₂中独立 的As平面也是"之"字形As链平铺的结构, As链 沿着b方向延伸, 沿着c方向平铺.

图3给出了EuFeAs2单晶样品在bc面内的归 一化电阻随温度变化(R/R_{300 K}-T)的关系曲线. 从该曲线上可以看出, EuFeAs2在整个温度区间呈 现金属行为,随着温度降低,电阻值下降,同时在 电阻曲线上出现两个异常转变,转变温度在46 K 和110 K附近. 对电阻温度曲线数据进行求导处 理,可以进一步观察相变的特征行为,如图3内插 图所示. 在110 K的转变实际上包含两个相邻的 相变,转变温度分别为110 K和98 K,这与铁基超 导母体化合物中常常发生的邻近的结构相变和反 铁磁相变相符合. 文献报道,在Call2的过掺杂样 品Ca0.73La0.27FeAs2的电阻导数曲线中也观察到 两个临近的电阻跳变, 通过中子散射实验、同步 辐射X射线衍射实验以及µ子自旋共振实验,发现 Ca0.73La0.27FeAs2在58K时发生单斜到三斜空间 群的结构相变, 而在54 K时发生反铁磁相变^[15]. 在铁基1111体系和122体系铁基超导母体中同样 存在结构相变、反铁磁相变在邻近温度发生的行为^[4,16].对于该Eu112体系结构相变和反铁磁相变的发生顺序需要进一步通过实验确定.另一方面对于含有Eu²⁺离子的层状材料,Eu²⁺在低温下常发生反铁磁相变,其相变温度一般在19—39 K之间^[17-19].在46 K的电阻异常与Eu²⁺的反铁磁相变相符.



图 3 EuFeAs2 单晶样品 bc 面内归一化电阻随温度变化 关系, 插图为归一化电阻的一阶导数随温度变化关系 Fig. 3. Temperature dependence of normalized electrical resistivity measured in bc plane of EuFeAs2 single crystal. Insert is temperature derivative of electrical resistivity of EuFeAs2 single crystal.

为了进一步分析电阻上的异常行为和体系 中反铁磁相变的对应关系,对EuFeAs2单晶进行 了不同方向的直流(DC)磁化率测量. 图4(a)和 图4(b)分别给出了单晶样品在10000 Oe (1 Oe = $10^{3}/(4\pi)$ A/m) 外场下, 磁场平行于 bc 面和垂直 于bc面时磁化率随温度变化关系(χ -T)曲线.在 磁场平行于bc面时,单晶磁化率在46 K表现出反 铁磁行为;磁场垂直于bc面时,在反铁磁转变温度 以下,随着温度降低,磁化率有饱和趋势.这种在 磁化率上观察到的各向异性在含有 Eu²⁺ 的层状材 料,如EuFe₂As₂和EuCu₂Sb₂中常有报道^[20].在 EuFe₂As₂中,磁场平行于Fe₂As₂层时,磁化率在 低温下有反铁磁行为特征,在垂直于Fe2As2层时 随温度降低, 磁化率有饱和的趋势^[21]. 零场中子衍 射实验结果表明:在EuFe₂As₂中,平行于Fe₂As₂ 层方向, Eu²⁺磁矩在面内呈铁磁性排列; 而在 垂直Fe₂As₂层方向, Eu²⁺层间是反铁磁排列^[22]. EuFeAs₂中的Eu²⁺磁矩排列是否和122型 EuFe₂As₂类似, 需要进一步的实验证实.

根据居里外斯公式 $\chi = \chi_0 + C/(T + \theta_P)$ (其中 χ_0 是温度无关项, *C*是居里常数, θ_P 是外斯温度), 对磁场平行于 bc 面的数据作出 $1/\chi$ -T 的关系曲线, 并对高温段进行线性拟合,结果如图 5 所示. 拟合 得到居里常数 C = 7.49 emu·K·mol⁻¹·Oe⁻¹,分子 有效磁矩为 μ_{eff} = 7.7 μ_B ,与 Eu²⁺ 离子的有效磁矩 理论值 7.9 μ_B 接近,而铁基超导体中 Fe²⁺ 离子的有 效磁矩量级通常小于 $1\mu_B$ ^[23].由于 Fe²⁺ 离子的有 效磁矩远小于 Eu²⁺ 离子,在磁化率数据上观察不 到 110 K 附近 Fe²⁺ 的反铁磁相变,而 45 K 处的电 阻和磁化率的异常是 Eu²⁺ 反铁磁相变的结果.



图 4 10000 Oe 磁场下 EuFeAs2 单晶样品磁化率随温度变 化关系曲线 (a) 磁场平行于 bc 面; (b) 磁场平行于 a 方向 Fig. 4. Temperature dependence of the magnetic susceptibility for EuFeAs2 measured under H = 10000 Oe: (a) Magnetic field parallel to bc plane; (b) magnetic field parallel to a axis.

对于目前发现的两种112型铁基体系 Cal12 和Eu112,在(Ca, *RE*)FeAs₂里,层间阳离子都是 由+2价的Ca²⁺和+3价的稀土离子配合才能得到 稳定的相,而低掺杂或未掺杂的母体 CaFeAs₂都 不稳定,至今没有成功制备出来.而对Eu112相, 目前可以制备出稳定的未掺杂母体化合物和稀 土元素掺杂的超导体,但在高浓度掺杂情况下的 单晶质量仍然较差.由于Eu元素本身存在+2价 和+3价两个化学价态,Fe₂As₂层间阳离子的价态 是不是112体系中化学相稳定存在的因素是一个 值得继续探索的问题.同时对该Eu112体系的完 整载流子掺杂电子态相图的绘制是下一步的重点 研究工作.



图 5 磁场平行于 bc 面时 EuFeAs₂ 单晶样品磁化率倒数与 温度的关系曲线 (黑色), 及顺磁区域线性拟合曲线 (红色) Fig. 5. Inverse susceptibility versus temperature of Eu-FeAs₂ for magnetic field parallel to bc plane (black line), and the linear fit to the Currie-Weiss law in the paramagnetic region (red line).

4 结 论

用 CsCl 助熔剂方法, 成功生长了新型铁基112 型化合物 EuFeAs₂ 的单晶样品.通过电阻率和磁 化率的测量, 发现 EuFeAs₂ 在低温下存在三种可 能的相变,包括体系的结构相变以及 Fe₂As₂ 层和 Eu²⁺ 层的反铁磁相变. EuFeAs₂ 的成功合成为研 究铁基112 体系独特的结构和电子态相图提供了新 的平台,对该体系进一步的载流子掺杂研究和高质 量单晶的生长将会有助于深入理解超导与磁有序 之间的共存和相互竞争关系.

参考文献

- Kamihara Y, Watanabe T, Hirano M, Hosono H 2008 J. Am. Chem. Soc. 130 3296
- [2] Chen X, Dai P, Feng D, Xiang T, Zhang F C 2014 Natl. Sci. Rev. 1 371
- [3] Chen H, Ren Y, Qiu Y, Bao W, Liu R H, Wu G, Wu T, Xie Y L, Wang X F, Huang Q, Chen X H 2009 *EPL* 85 17006
- [4] Luetkens H, Klauss H H, Kraken M, Litterst F J, Dellmann T, Klingeler R, Hess C, Khasanov R, Amato A, Baines C, Kosmala M, Schumann O J, Braden M, Hamann-Borrero J, Leps N, Kondrat A, Behr G, Werner J, Buchner B 2009 Nat. Mater. 8 305
- [5] Zhao J, Huang Q, de la Cruz C, Li S, Lynn J W, Chen Y, Green M A, Chen G F, Li G, Li Z, Luo J L, Wang N L, Dai P 2008 Nat. Mater. 7 953
- [6] Yakita H, Ogino H, Okada T, Yamamoto A, Kishio K, Tohei T, Ikuhara Y, Gotoh Y, Fujihisa H, Kataoka K,

Eisaki H, Shimoyama J 2014 J. Am. Chem. Soc. **136** 846

- [7] Kawasaki S, Mabuchi T, Maeda S, Adachi T, Mizukami T, Kudo K, Nohara M, Zheng G Q 2015 *Phys. Rev. B* 92 180508
- [8] Li M Y, Liu Z T, Zhou W, Yang H F, Shen D W, Li W, Jiang J, Niu X H, Xie B P, Sun Y, Fan C C, Yao Q, Liu J S, Shi Z X, Xie X M 2015 *Phys. Rev. B* **91** 045112
- [9] Rutzinger D, Bartsch C, Doerr M, Rosner H, Neu V, Doert T, Ruck M 2010 J. Solid State Chem. 183 510
- [10] Ni N, Allred J M, Chan B C, Cava R J 2011 Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108 E1019
- [11] Yu J, Liu T, Pan B J, Ruan B B, Wang X C, Mu Q G, Zhao K, Chen G F, Ren Z A 2017 Sci. Bull. 62 218
- [12] Yakita H, Ogino H, Sala A, Okada T, Yamamoto A, Kishio K, Iyo A, Eisaki H, Shimoyama J 2015 *Physica* C 518 14
- [13] Sun L, Guo J, Chen G, Chen X, Dong X, Lu W, Zhang C, Jiang Z, Zou Y, Zhang S, Huang Y, Wu Q, Dai X, Li Y, Liu J, Zhao Z 2010 *Phys. Rev. B* 82 134509
- [14] Matsubayashi K, Munakata K, Isobe M, Katayama N, Ohgushi K, Ueda Y, Kawamura N, Mizumaki M, Ishimatsu N, Hedo M, Umehara I, Uwatoko Y 2011 *Phys. Rev. B* 84 024502
- [15] Jiang S, Liu C, Cao H B, Birol T, Allred J M, Tian W, Liu L, Cho K, Krogstad M J, Ma J, Taddei K M, Tanatar M A, Hoesch M, Prozorov R, Rosenkranz S, Uemura Y J, Kotliar G, Ni N 2016 *Phys. Rev. B* **93** 054522
- [16] Koo J, Park J, Kook Cho S, Duk Kim K, Park S Y, Hee Jeong Y, Jun Park Y, Yeong Koo T, Hong K P, Lee C H, Kim J Y, Cho B K, Bong Lee K, Kim H J 2010 J. Phys. Soc. Jpn. **79** 114708
- [17] Ren Z, Zhu Z, Jiang S, Xu X, Tao Q, Wang C, Feng C, Cao G, Xu Z A 2008 Phys. Rev. B 78 052501
- [18] Feng C, Ren Z, Xu S, Jiang S, Xu Z A, Cao G, Nowik I, Felner I, Matsubayashi K, Uwatoko Y 2010 Phys. Rev. B 82 094426
- [19] Ballinger J, Wenger L E, Vohra Y K, Sefat A S 2012 J. Appl. Phys. **111** 07E106
- [20] Sengupta K, Alzamora M, Fontes M B, Sampathkumaran E V, Ramos S M, Hering E N, Saitovitch E M B, Paulose P L, Ranganathan R, Doert T, Jemetio J P F 2012 J. Phys. Condens. Matter 24 096004
- [21] Guguchia Z, Bosma S, Weyeneth S, Shengelaya A, Puzniak R, Bukowski Z, Karpinski J, Keller H 2011 Phys. Rev. B 84 144506
- [22] Xiao Y, Su Y, Meven M, Mittal R, Kumar C M N, Chatterji T, Price S, Persson J, Kumar N, Dhar S K, Thamizhavel A, Brueckel T 2009 *Phys. Rev. B* 80 174424
- [23] McGuire M A, Christianson A D, Sefat A S, Sales B C, Lumsden M D, Jin R, Payzant E A, Mandrus D, Luan Y, Keppens V, Varadarajan V, Brill J W, Hermann R P, Sougrati M T, Grandjean F, Long G J 2008 *Phys. Rev. B* 78 094517

SPECIAL TOPIC — Tenth anniversary of the discovery of iron-based high temperature superconductors

Single crystal growth and characterization of the 112-type iron-pnictide EuFeAs₂*

Yu Jia¹⁾²⁾ Liu Tong¹⁾²⁾ Zhao Kang¹⁾²⁾ Pan Bo-Jin¹⁾²⁾ Mu Qing-Ge¹⁾²⁾ Ruan Bin-Bin¹⁾²⁾ Ren Zhi-An^{1)2)3)†}

 (Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

2) (School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

3) (Collaborative Innovation Center of Quantum Matter, Beijing 100190, China)

(Received 20 July 2018; revised manuscript received 10 August 2018)

Abstract

The 112-type (Ca, RE)FeAs₂ (RE = rare earth) superconductors are very special among the iron-based superconductors for their particular crystal structures with arsenic chain configuration and attractive electronic phase diagram with the coexistence of superconductivity and antiferromagnetism upon carrier doping, while the chemical phases are absent for the low doping level or undoped parent compound. Here we report the single crystal growth method and physical characterizations for the newly discovered Eu 112 type parent compound EuFeAs₂. The single crystal of Eu-FeAs₂ is grown by high temperature solution method through using CsCl as the flux under the constant temperature of 800 °C with the molar ratio of the starting materials Eu : Fe : As : CsCl = 1 : 1 : 4 : 18. The as-grown crystal is shinyplatelike piece with a typical size of $1 \text{ mm} \times 1 \text{ mm} \times 0.2 \text{ mm}$, and quite stable in air. The chemical composition of EuFeAs₂ crystal is confirmed by energy-dispersive X-ray spectroscopy. The single crystal X-ray diffraction analysis at room temperature indicates that EuFeAs₂ crystallizes into an orthorhombic crystal structure with the space group Imm2 (No. 44), and the refined lattice parameters are a = 21.285(9) Å, b = 3.9082(10) Å, c = 3.9752(9) Å, which are different from those of the Ca 112 compound, but similar to those of unique zigzag As-As chain configuration presented in the layered crystal structure. Electrical resistivity measurements show three anomalies near 110 K, 98 K, and 46 K. The former two anomalies with relatively high temperature imply that the structural and antiferromagnetic transitions are related to Fe^{2+} sublattice, which is similar to other iron-based parent compounds. The low temperature anomaly at 46 K is attributed to the antiferromagnetic transition of Eu^{2+} sublattice, which is also confirmed by the corresponding transition observed in the direct current magnetic susceptibility measurement. The magnetic susceptibility of EuFeAs₂ exhibits obvious anisotropy blow 46 K when the magnetic field is parallel or perpendicular to the bc plane, while the exact orientation of the Eu^{2+} moment needs further studying. The discovery of EuFeAs₂ provides a new platform for further studying the unique crystal structure and electronic state phase diagrams in the 112-type iron-based superconducting family, and may shed new light on the correlations between superconductivity and magnetism.

Keywords: EuFeAs2, single crystal growth, structural transition, antiferromagnetic transitionPACS: 74.70.-b, 74.70.Xa, 74.25.-qDOI: 10.7498/aps.67.20181393

^{*} Project supported by the National Basic Research Program of China (Grant No. 2016YFA0300301), the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11474339, 11774402), and the Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences.

[†] Corresponding author. E-mail: renzhian@iphy.ac.cn